PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-251820

(43) Date of publication of application:

14.09.2000

(51)Int.Cl.

H01J 37/20 B25J 7/00 G01N 1/28 G01N 1/32 G01R 1/06 G01R 31/28

(21) Application number:

11-056602

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

04.03.1999

(72)Inventor:

MATSUSHIMA MASARU

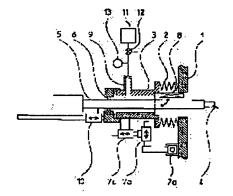
UMEMURA KAORU TOMIMATSU SATOSHI

KOIKE HIDEMI

(54) MANIPULATOR AND PROBE DEVICE AND SAMPLE PREPARATION DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manipulator for operating a probe inside a vacuum device capable of improving a device operation rate by shortening stopping time of the device during probe exchange. SOLUTION: A vacuum introducing mechanism is provided capable of taking in and out a probe from a vacuum chamber 1 of a device main body, without breaking the vacuum chamber 1 to atmosphere. Actually, an air lock chamber 3 is provided on the vacuum chamber 1, and this air lock chamber 3 is connected to the vacuum chamber 1 of the main body by a vacuum bellows 2. A probe holder 5 is attached to the air lock chamber 3, and a probe 4 is moved together with the air lock chamber 3 by a moving mechanism 7 provided on the main body. The air lock chamber 3 enable evacuation through an exhaust port 9 and a space between the air lock chamber 3, and the vacuum chamber 1 is partitioned by a vacuum valve 8. A second moving mechanism 10 is provided so that the probe 4 moves between the air lock chamber 3 and the vacuum chamber 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-251820 (P2000-251820A)

(43)公開日 平成12年9月14日(2000.9.14)

(51) Int.Cl.7		識別記号		ΡI			Ť	·-マコード(参考)	
H01J	37/20			H01J	37/20		Z	2G011	
B 2 5 J	7/00			B 2 5 J	7/00			2G032	
G01N	1/28			G 0 1 N	1/32		В	3F060	
	1/32			G 0 1 R	1/06		E	5 C 0 0 1	
G01R	1/06			G01N	1/28		G	9 A 0 0 1	
			審査請求	未請求 請求	表項の数18	OL	(全 9 頁)	最終頁に続く	

(21)出願番号

特願平11-56602

(22)出願日

平成11年3月4日(1999.3.4)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 松島 勝

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 梅村 馨

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100068504

弁理士 小川 勝男

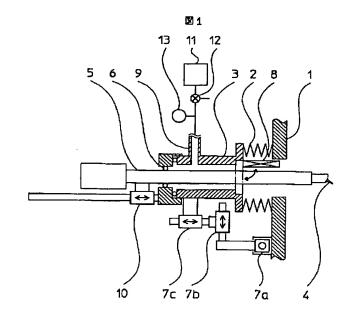
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 マニピュレータおよびそれを用いたプローブ装置、試料作製装置

(57)【要約】

【課題】真空装置内でプローブを操作するマニピュレータにおいて、プローブ交換時における装置の停止時間を 短縮し、装置稼働率を向上させるマニピュレータを提供 する。

【解決手段】装置本体の真空チャンバからプローブを出し入れする際に、真空チャンバ1を大気開放することなく行える真空導入機構を設ける。具体的には、真空チャンバ1にエアロック室3を設け、このエアロック室3を、本体の真空チャンバ1と真空ベローズ2で接続する。エアロック室3にはプローブホルダ5を取り付け、本体に設けた移動機構7によりエアロック室3ごとプローブ4を移動する。エアロック室3は排気ポート9から真空排気を可能とし、エアロック室3と真空チャンバ1の間を真空バルブ8で仕切る。プローブ4はエアロック室3と真空チャンバ1の間を移動できるよう、第二の移動機構10を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】針状部材と、該針状部材を真空容器内で移動させるための移動手段からなるマニピュレータであって、該針状部材は、該真空容器を大気開放することなしに、該真空容器からの出し入れを可能とする真空導入手段を具備することを特徴とするマニピュレータ。

、【請求項2】請求項1記載のマニピュレータにおいて、 該真空導入手段は、該真空容器に真空ベローズで接続され、かつ該移動手段によって該針状部材と共に移動する 小型真空容器と、該小型真空容器内を真空排気する排気 手段と、該真空容器と該小型真空容器の仕切を開閉する 真空バルプと、該針状部材が該真空容器と該小型真空容 器の間を移動可能とする第二の移動手段によって構成されることを特徴とするマニピュレータ。

【請求項3】請求項2記載のマニピュレータにおいて、 該小型真空容器は該真空容器に設けた案内手段に沿って 移動する構造を有することを特徴とするマニピュレー タ。

【請求項4】請求項2記載のマニピュレータは、該真空容器への取り付けに用いるフランジを有し、かつ、該小型真空容器は該フランジに設けた案内手段に沿って移動する構造を有することを特徴とするマニピュレータ。

【請求項5】請求項2記載のマニピュレータにおいて、該針状部材は探針と探針保持具で構成され、該探針保持具は該探針の外周の少なくとも3箇所を中心軸に向かって弾性力により固定する構造とし、該探針は該探針保持具に対して抜き差しが可能であることを特徴とするマニピュレータ。

【請求項6】請求項2記載のマニピュレータにおいて、 該針状部材は探針と探針保持具で構成され、該探針の先端を保護するための保護カバーを有し、該マニピュレー タの使用状況に応じて、該保護カバーが該探針を収納す る機構を具備することを特徴とするマニピュレータ。

【請求項7】請求項5または6記載のマニピュレータにおいて、該針状部材は該探針が複数個取り付けられる構造を有し、使用時はそのうちの1個を選択する機構を具備したことを特徴とするマニピュレータ。

【請求項8】請求項2から7のうちいずれかに記載のマニピュレータにおいて、該針状部材の先端が薄板状になっていることを特徴とするマニピュレータ。

【請求項9】試料を載置する試料ステージと、荷電粒子ビームの照射光学系と、該荷電粒子ビームの照射によって試料から発生する二次粒子を検出する二次粒子検出器と、該二次粒子検出器で得られた二次粒子像を表示する画像表示器を具備し、かつ、請求項1から8のいずれかに記載のマニピュレータを用いて、該針状部材の操作を行うことを特徴とするプローブ装置。

【請求項10】請求項9記載のプローブ装置において、 該マニピュレータを複数個具備し、該針状部材を各々独 立に移動可能であることを特徴とするプローブ装置。 【請求項11】請求項9または10記載のプローブ装置において、該荷電粒子ビームが集束イオンビーム、投射イオンビーム、電子ビームのうちのいずれかであることを特徴とするプローブ装置。

【請求項12】請求項9から11のうちいずれかに記載のプローブ装置において、該針状部材は、該針状部材を該試料に接触させて、該試料基板の一部に電圧を供給する電圧印加手段に連結していることを特徴とするプローブ装置。

【請求項13】請求項9から11のうちいずれかに記載のプローブ装置において、該針状部材に電圧を供給する電圧印加手段を具備し、該試料基板の電気的特性を測定することを特徴とするプローブ装置。

【請求項14】請求項9から11のうちいずれかに記載のプローブ装置において、該針状部材に電圧を供給する電圧印加手段と、該試料基板に接触した際に流れる電流を検知する電流検出部を具備し、該試料基板への接触を判別することを特徴とするプローブ装置。

【請求項15】試料を載置する試料ステージと、エネルギービームの照射光学系と、該エネルギービームの照射 によって試料から発生する二次粒子を検出する二次粒子検出器と、該二次粒子検出器で得られた二次粒子像を表示する画像表示器を具備し、かつ、請求項1から8のいずれかに記載のマニピュレータを用いて、該二次粒子検出器の視野内において該針状部材で該試料の一部を分離させる操作を行うことを特徴とする試料作製装置。

【請求項16】請求項15記載の試料作製装置において、該エネルギービームは集束イオンビーム、投射イオンビーム、レーザビームのうちのいずれかであることを特徴とする試料作製装置。

【請求項17】請求項15または16記載の試料作製装置において、該マニピュレータにおける該針状部材がガラスもしくは高分子材料からなることを特徴とする試料作製装置。

【請求項18】請求項15または16記載の試料作製装置において、該針状部材に電圧を供給する電圧印加手段と、該試料基板に接触した際に流れる電流を検知する電流検出部を具備し、該試料基板への接触を判別することを特徴とする試料作製装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、真空内における微小探針のマニピュレータに係り、特に電子素子の性能を評価、ないしは不良を解析するプローブ装置、もしくは集束イオンピームを利用して、試料片から分析や観察に必要な部分のみを加工・摘出する試料作製装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の電子素子の評価方法として、プロープ装置がある。これは、大気中で光学顕微鏡により検

査試料を観察しながら、電気的特性を測定したい位置に 探針を接触させる方法である。この探針に、電圧印加手 段と電流測定手段を設けることにより、素子の電流電圧 特性を評価したり、導通不良箇所を特定することが可能 である。近年では、半導体の高集積化が進み、サブミク ロンの配線を持った電子素子の評価をする手法が考案さ れている。例えば、特開平9-326425号公報に開 示されているように、前述したプローブ装置において、 光学顕微鏡の代わりに、真空中にて荷電粒子を試料に照 射し、その二次電子を検出する顕微手段(電子顕微鏡 等)を用い、高精度の探針移動機構により、探針を試料 に接触させている。

【0003】また、半導体の高集積化により、走査型電 子顕微鏡(以下、SEMと略記)の分解能では測定でき ないほど極微細なものにおける解析の必要性が高まって いる。そのため、SEMに代わって観察分解能が高い透 過型電子顕微鏡(以下、TEMと略記)が有力視されて いる。TEMで観察するには、試料の観察部の厚さを、 0. 1 μ m まで薄く加工する必要がある。この加工手順 の例として、まず、ダイシング装置を用いてウエハ等の 試料から、観察すべき領域を含む短冊状ペレットを切り 出す。このペレットの一部に、集束イオンピーム(以 下、FIBと略記)を照射して、薄壁状の部分を作る。 TEM観察時には、この薄壁面に垂直に電子線を照射す ることで行う。この方法の欠点は、一つの試料を作成す るのに、作業が煩雑になることや、ウエハを切断するた めに分析できない箇所があるという点が挙げられる。こ れに対し、特開平5-52721号公報では、以下のよ うな手法が開示されている。これは、試料の姿勢を変化 させながら、FIB加工のみで試料を切り出してしまう 方法である。ここでは、切り出し後の試料摘出手段とし て、前述したプローブ装置の探針と同様な形状の操作針 を試料に接触させ、堆積ガスを供給し、イオンビームア シストデポジション膜を形成することで、操作針と試料 との接着を行い、ウエハから分離を行う。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者のプローブ装置、および後者の試料作製装置ともに共通な問題として、探針、もしくは操作針(以下、プローブという)を試料に接触させるため、プローブ先端の劣化が挙げられる。接触させたときのプローブの変形が、弾性変形領域に収まるような荷重・変位であるよう、接触検出の方法も検討されている。しかし、試料の表面が絶縁物で覆われているなど、接触面の状態が常に同一ではないため、プローブの接触検知不良により必要以上に試料に押し付ける場合が生じる。これにより、プローブ先端が塑性変形し、次回以降のプローブの使用が困難になる。この問題は、半導体の集積度が上がり、プローブ先端が細くなるに従って、顕著となる。

【0005】また、後者の試料作製装置に限って言え

ば、プローブ先端を試料に接着し、ウエハから試料を分離した後に、別の試料を作成・摘出する際には、プロープ先端を切断しなければならない。この切断はFIBで行え、さらに切断面をFIBで鋭利にすることは可能であるが、平面的な加工のみため、厚さ方向に太い、くさび状のプローブになってしまう。このため、繰り返し使用するには、限度がある。

【0006】上記理由により、いずれの装置においてもプローブは消耗品であり、かなりの頻度で交換が必要となる。ところで、これらの装置に取り付けられているプローブ移動用のマニピュレータは、機構部とプローブが一体になっており、プローブ交換時には真空チャンバを大気開放して、本体から取り外さなければならなかった。このため、交換後の真空立ち上げにおいて、長時間を必要とし、装置の稼働率を低下させる原因となっていた。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、以下の手段を用いる。

【0008】装置本体である真空チャンバからプローブを出し入れする際に、真空チャンバを大気開放することなく行える真空導入機構を設ける。具体的には、真空チャンバにはエアロック室を設けており、このエアロック室は、本体の真空チャンバとフレキシブルな真空ベローズで接続されている。プローブを保持している部材は、エアロック室に取り付けられており、本体に設けられた移動機構によりエアロック室ごとプローブを移動できる。エアロック室は真空排気が可能な構造であり、エアロック室と真空チャンバの間は真空バルブで仕切られている。プローブはエアロック室と真空チャンバの間を移動できるよう、第二の移動機構を設ける。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例にしたがって説明する。

【0010】図1は本発明の実施例を示すマニピュレー 夕の概略構成図である。図において、装置本体である真 空チャンバ1には、真空ベローズ2で接続されたエアロ ック室3が設けてある。プローブ4を装着したプローブ ホルダ5は真空シール6を介してエアロック室3に固定 されており、真空チャンバ1に設けられた3軸の移動機 構7a、7b、7cにより、エアロック室3ごとプロー ブ4の移動が可能である。エアロック室3と真空チャン バ1の仕切りは、開閉可能な真空バルブ8で構成されて おり、排気ポート9は三方弁12を介して真空ポンプ1 1に接続されている。この三方弁12を切り替えること により、エアロック室3の真空排気/大気開放が可能と なる。排気ポート9には、エアロック室3内の圧力を測 定するための真空ゲージ13が設けられており、この圧 力がある設定値内に入っていない場合、真空バルブ8が 開かない構造となっている。また、プローブ4はエアロ

ック室3と真空チャンバ1の間を移動できるよう、プロープホルダ5には1軸の移動機構10が設けられている。

【0011】ここで、本実施例の動作について説明す る。プローブ4を交換する際には、図2 (a) に示すよ うに、移動機構10を用いてプロープホルダ5を退避さ せ、真空バルブ8を閉じる。これにより、エアロック室 3は本体真空チャンバ1とは別空間になる。ここで、エ アロック室3に排気ポート9からエアを入れて、エアロ ック室3内を大気圧にする。この後、プローブホルダ5 をエアロック室3から取り外し、図2(b)の状態にし てからプローブ4の交換作業を行う。交換後は、逆の手 順でプロープホルダ5をエアロック室3に取り付け、エ アロック室3内を真空排気する。エアロック室3と真空 チャンバ1の圧力差が小さくなったことを確認し、真空 バルプ8を開く。プローブホルダ3は移動機構10によ り、真空チャンバ1内に導入される。プローブ4を所望 の位置に操作するには3軸の移動機構7a、7b、7c を用いてエアロック室3ごと移動させる。これにより、 真空チャンバを大気開放すること無く、プローブの交換 が可能となる。

【0012】図3は本発明の別の実施例を示すマニピュ レータの詳細断面図である。また、図4は図3の平面 図、図5は図3のAA断面図、そして図6はプローブホ ルダの断面図である。図において、装置本体である真空 チャンバ31には、ベースフランジ32が真空シール3 3を用いて固定されている。エアロック室34は真空べ ローズ35を介して、ベースフランジ32に接続されて おり、エアロック室34の端面には真空バルブ37を備 えている。真空バルブ37の開閉は、エアロック室34 内に構成した筒状のバルブ開閉機構38を回転させるこ とによって行う。また、エアロック室34には、排気用 の配管39が真空ベローズ40を介してベースフランジ 32に取り付けられており、排気ポート41に通じてい る。これにより、エアロック室34内の排気(あるいは リーク)を行う。ベースフランジ32にはY軸用リニア ガイド42を介してベース(Y)43が取り付けられて いる。その両端には、ベースフランジ32に固定された Y軸用リニアアクチュエータ44と予圧用押しバネ45 aが仕込まれており、ベース(Y)43のY軸方向への 移動を行う。同様に、ベース(Y)43には2軸用リニ アガイド46を介してベース(Z)47が取り付けられ ており、ベース(Y)43に固定されたZ軸リニアアク チュエータ48と予圧押しバネ45bによって、2軸方 向への移動を行う。X軸方向へは、X軸用リニアガイド 49に沿ってベース(X)50を移動させるが、このと き、X軸用リニアアクチュエータ51の出力をてこ55 を用いて反転させている。ベース(X)50には、エア ロック室32、およびプローブ36を装着しているプロ ープホルダ54を固定しているため、各軸のリニアアク

チュエータ44,48,51を駆動させることにより、プロープ36の移動を行える。プローブ36の位置は、各軸のエンコーダ52a、52b、52cの出力値によって把握され、高精度な位置制御が可能である。プローブホルダ54はエアロック室32の軸に沿って、真空を保ちながら移動可能なように、軸用の真空シール53を設けてある。プローブホルダ54の先端には、給電用に板バネ状の導電板56が接触しており、この導電板56は導線57によってベースフランジ32に設けられた電流導入端子58に接続されている。これによりプローブへの給電が可能である。なお、給電部材として板バネを用いる理由は、接触抵抗を小さくして安定した給電を実現するためと、プローブホルダ54の先端を一方向に荷重をかけることにより、先端の振動の発生を抑制するためである。

【0013】図6(a)に示すようにプローブホルダ54は、プローブ36が取り付けられたロッド59と、外筒60の二重構造になっており、Oリング61によって真空シールされている。ロッド59はツマミ62の操作によって、外筒60に対して直線および回転移動を行う。ロッド59はストッパ63によりその位置が固定され、プローブ先端の収納・保護が可能となる。また、プローブホルダ54の先端には、板バネ64を径方向に6ヶ配列したプローブソケット66を有している。この板バネ64によりプローブ36を固定するため、プローブ36の抜き差しが可能となり、ネジ等を用いるこプローブ36の取り外しが容易となっている。プローブ36の取り外しが容易となっている。プローブ36の取り外しが容易となっている。プロージ36の接触による給電が可能となっている。

【0014】ここで、本実施例の動作について説明す る。プローブ36の先端の破損、または消耗によりプロ ープ36を交換する際には、まず、図6(b)に示すよ うに、ツマミ62を直進および回転させて、プローブ3 6を外筒60に収納する。その後、図7(a)に示すよ うに、プローブホルダ54を手動により退避させ、バル ブ開閉機構38を動作させて真空バルブ37を閉じる。 これにより、エアロック室34は本体真空チャンバ31 とは別空間になる。ここで、エアロック室34に排気ポ ート41からガス、例えばエアを入れて、エアロック室 34内を大気圧にする。この後、さらにプロープホルダ 54をエアロック室34から引き抜き、ツマミ63を元 に戻して図7(b)の状態にし、プローブ36の交換作 業を行う。なお、ここではプローブはタングステン製の 針67と針支持部材68で構成され、針67は針支持部 材68に溶接により固定されている。プローブ36の交 換はピンセット等を用いて、図6(c)、(d)に示す ようにプローブ36をプローブホルダ54から引き抜 き、替わりに新品のプローブを差し込む。交換後は、逆 の手順で組み込めば良い。まず、プローブホルダ36を

エアロック室34に挿入し、エアロック室34内を真空排気する。エアロック室34と真空チャンバ31の圧力差が小さくなるまで、例えばエアロック室34の圧力が5Pa以下になったことを確認して、バルブ開閉機構38を動作させて真空バルブ37を開く。プローブホルダ54はさらに手動により、真空チャンバ31内に挿入される。プローブ36を所望の位置に操作するには3軸のリニアアクチュエータ44、48、51を用いてエアロク室34ごと移動させる。これにより、真空チャンバの交換が可能となる。なお、装置本体の真空チャンバ31には、ベースフランジ32で固定しているだけなので、本体への取り付け/取り外しは容易な構造となっている。このため、本体の取り付けフランジの寸法および位置に合わせることにより、既納装置に対しても追加取り付けが容易である。

【0015】図8は本発明の別の実施例を示すマニピュレータを搭載したプローブホルダ断面図である。図において、ロッド59の先端にはプローブ36が放射状に6ヶ配置され、各々板バネ64にて固定されている。ロッド59は外筒60に対して回転が可能な構造となっており、ロッド59の先端のツマミ63を回転させることにより、使用するプローブを選択することが可能である。これにより、プローブ先端の破損あるいは消耗時に交換のために行うプローブホルダの引出し作業の頻度が、およそ1/6に減少し、装置稼働率がさらに向上することになる。

【0016】図9は本発明の実施例をプローブ装置に適 用したときの概略図である。図において、電子銃71か ら放出された電子ビーム72は、アパーチャ73により 成形され、集束レンズ74により電子ビーム72の拡が りを制御し、偏向器75と対物レンズ76を通ることに よってステージ77上の所望の位置に集束される。ステ ージ77上には、半導体ウエハや半導体チップ等の基板 78を載置しており、ステージ位置コントローラ79に より基板78の評価する素子の位置を特定する。複数の マニピュレータ80a、80b、80cに装着された各 々のプローブ81a、81b、81cは、ステージ77 とは独立に駆動可能なプローブ位置コントローラ82 a、82b、82cによって、基板78上の評価素子の 位置まで移動させる。移動の際は、電子ピームコントロ ーラ83により、基板78の評価素子近傍に電子ピーム 72を走査して、基板78からの二次電子を二次電子検 出器84により検出し、その画像をディスプレイ85で 表示/観察しながら行う。プローブ81が接触した基板 78の微小部分に電圧を印加できるよう、各プローブ8 1a、81b、81cには電源86が接続されている。 同時に、各プローブ81a、81b、81cに流れる電 流も測定できる様、電流計87が接続されている。評価 方法の例として、ウエハ上に形成されたMOSデバイス

における場合を記す。まず、3つのプローブをそれぞれ、ソース電極、ゲート電極、ドレイン電極に接触させる。ここで、プローブを用いてソース電極をアースに落とし、プローブによりゲート電極の電圧をパラメータとして振りながら、プローブによりドレイン電圧と、ソースードレイン間を流れるドレイン電流の関係を測定する。これにより、MOSの出力特性を得ることができる。これらの動作は中央演算処理装置88によって、一括して制御されている。

【0017】なお、マニピュレータ80a、80b、80cは前述した図3に示したものと、同様な構成としている。これにより、測定評価時にプローブが破損しても、容易にプローブ交換が可能であるため、プローブ装置の稼働率を向上させることが可能である。

【0018】また、本実施例において、電子銃71をイオン源に置き換えて構成される照射光学系を用いたプロープ装置であっても、本発明のマニピュレータを用いることにより、同様の効果が得られる。

【0019】図10は本発明の実施例を試料作製装置に 適用したときの概略図である。図において、真空ポンプ 100によって内部を真空雰囲気にした試料室96およ びカラム101において、イオン源89から放出された イオンビーム90は、ピーム制限アパーチャ91により 成形され、集束レンズ74によりイオンビーム90の拡 がりを制御し、偏向器75と対物レンズ76を通ること によって、試料室に載置したステージ77上の所望の位 置に集束される。集束されたイオンビーム90、すなわ ちFIBは、基板78表面を走査した形状にスパッタす ることにより、試料92の精密な加工を行える。ステー ジ77上には、半導体ウエハや半導体チップ等の基板7 8と、摘出した試料92を保持する試料ホルダ93を載 置しており、ステージ位置コントローラ79により試料 加工および摘出をする位置の特定を行う。マニピュレー タ80に装着されたプローブ81は、ステージ77とは 独立に駆動可能なプローブ位置コントローラ82によっ て、基板78上の摘出位置まで移動させる。移動および 加工の際は、FIBコントローラ94により、基板78 の摘出位置近傍にFIBを走査して、基板78からの二 次電子を二次電子検出器84により検出し、その画像を ディスプレイ85で表示/観察しながら行う。試料92 の摘出には、基板78の姿勢を変化させながらFIB加 工を行うことにより、試料92をクサビ状に切り出し、 プロープ81先端を試料92に接触させる。接触部には デポガス源95を用いて堆積ガスを供給し、イオンビー ムアシストデポジション膜を形成することで、プローブ 81と試料92との接着を行う。この後、プローブ位置 コントローラ82によりプローブ81を基板78から引 き上げ、ステージ77上の試料ホルダ93の位置に移動 する。プローブ81を下降し、プローブ81に接着した 試料92のクサビ先端が試料ホルダ93の表面に接触し

たのを確認し、イオンビームアシストデポジション膜に て試料92の側面と試料ホルダ93とを接着する。プロ ープ81の先端はFIBによって試料92から切断さ れ、プローブ位置コントローラ82により、次の試料摘 出位置へ移動を行う。このようにして一枚の基板から所 望の数の試料を、一つの試料ホルダに移載することが可 能である。これらの動作は中央演算処理装置88によっ て、一括して制御されている。ここで、プローブ81に は、図11(a)に示すように先端を鋭利な形状にした ものや、同図(b)のように、プローブ先端をFIBで 加工して薄板状にしたものがある。後者はプローブの加 工に手間がかかるが、基板78への接触に際して細かな 位置決めの必要がなく、また、クサビ状の試料92をF IBで切り落とした後は図11(c)のようになるた め、幅広の分だけ繰り返し使用が出来るという利点があ る。

【0020】なお、前述した実施例と同様、マニピュレータは図3に示した構成としている。また、マニピュレータ内部のエアロック室は、配管97により三方弁98 および真空ポンプ98に接続されており、エアロック室内の真空排気/大気開放が可能な構造となっている。これにより、プローブが消耗あるいは破損しても、容易なプローブ交換を可能とし、試料作製装置の稼働率を向上させることが可能である。

【0021】また、本実施例において、偏向器75と対物レンズ76をマスク板と投射レンズに置き換えて構成される投射イオンビームを用いた試料作製装置、あるいは、イオン源89をレーザ光源に置き換えて構成されるレーザビームを用いた試料作製装置であっても、本発明のマニピュレータを用いることにより、同様の効果が得られる。

【0022】また、本実施例において、プローブ81をガラスや高分子材料で構成した場合、イオンビームアシストデポジション膜を形成せずに、静電気力を利用して試料92の摘出を行う。このため、プローブ81の先端を切断することはないが、不慮の事故による破損時の交換に対して、本発明のマニピュレータを用いることにより、同様の効果が得られる。

[0023]

【発明の効果】本発明により、プローブを本体の真空チャンバから出し入れする際に、真空チャンバを大気開放する必要がないため、装置の稼働率を向上させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例であるマニピュレータを説明するための概略構成図である。

【図2】本発明の実施例を示すマニピュレータの動作を 説明するための概略構成図である。

【図3】本発明の別の実施例を示すマニピュレータの詳

細断面図である。

【図4】本発明の図3の実施例であるマニピュレータの 平面図である。

【図5】本発明の図3の実施例であるマニピュレータの AA断面図である。

【図6】本発明の図3の実施例であるマニピュレータに 搭載したプロープホルダの断面図である。

【図7】本発明の図3の実施例であるマニピュレータの 動作を説明するための図である。

【図8】本発明の別の実施例であるマニピュレータに搭載したプロープホルダの断面図である。

【図9】本発明の別の実施例を示すプローブ装置の概略 構成図である。

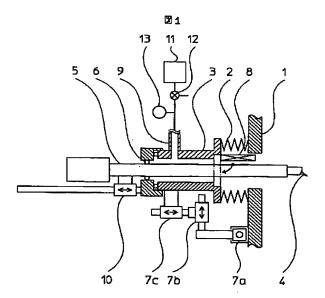
【図10】本発明の別の実施例を示す試料作製装置の概略構成図である。

【図11】本発明の図10の実施例である試料作製装置 における、プロープ先端形状を示す概略図である。

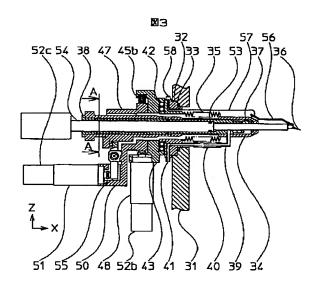
【符号の説明】

1…真空チャンパ、2…真空ベローズ、3…エアロック 室、4…プローブ、5…プローブホルダ、6…真空シー ル、7…3軸移動機構、8…真空バルブ、9…排気ポー ト、10…1軸移動機構、11…真空ポンプ、12…三 方弁、13…真空ゲージ、31…真空チャンバ、32… ベースフランジ、33…真空シール、34…エアロック 室、35…真空ベローズ、36…プローブ、37…真空 バルブ、38…バルブ開閉機構、39…排気用配管、4 0…真空ベローズ、41…排気ポート、42…Y軸用リ ニアガイド、43…ベース(Y)、44…Y軸用リニア アクチュエータ、45…予圧用押しバネ、46… Z軸用 リニアガイド、47…ベース(Z)、48… Z 軸用リニ アアクチュエータ、49…X軸用リニアガイド、50… ベース(X)、51…X軸用リニアアクチュエータ、5 2…エンコーダ、53…真空シール、54…プローブホ ルダ、55…てこ、56…導電板、57…導線、58… 電流導入端子、59…ロッド、60…外筒、61…Oリ ング、62…ツマミ、63…ストッパ、64…板パネ、 65…絶縁材、66…ソケット、67…針、68…針支 持部材、71…電子銃、72…電子ビーム、73…アパ ーチャ、74…集束レンズ、75…偏向器、76…対物 レンズ、77…ステージ、78…基板、79…ステージ 位置コントローラ、80…マニピュレータ、81…プロ ープ、82…プロープ位置コントローラ、83…電子ビ ームコントローラ、84…二次電子検出器、85…ディ スプレイ、86…電源、87…電流計、88…中央演算 処理装置、89…イオン源、90…イオンビーム、91 …ピーム制限アパーチャ、92…試料、93…試料ホル ダ、94…FIBコントローラ、95…デポガス源、9 6…試料室、97…配管、98…三方弁、99…真空ポ ンプ、100…真空ポンプ、101…カラム。

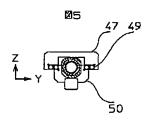




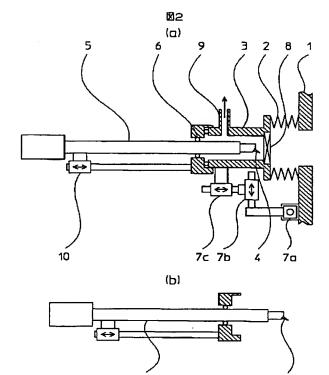
【図3】



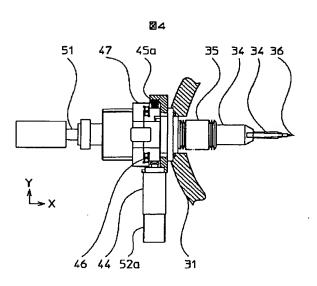
【図5】

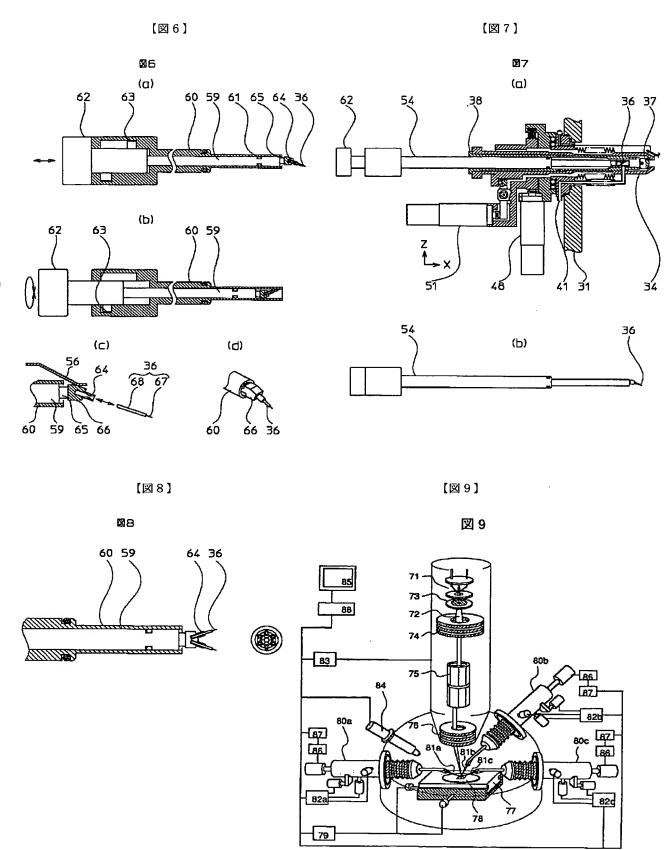


[図2]



[図4]

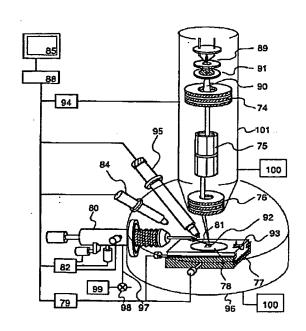




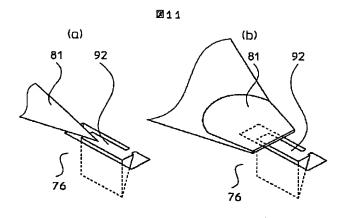
)

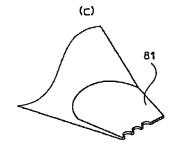
【図10】

図10



【図11】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

)

識別記号

G 0 1 R 31/28

(72)発明者 富松 聡

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72)発明者 小池 英巳

茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会

社日立製作所計測器事業部内

FΙ

G 0 1 R 31/28

テーマコート'(参考)

ĸ

Fターム(参考) 2G011 AA02 AA12 AB01 AC01 AC02

AC06 AC12 AC21 AE03 AF06

2G032 AF02 AF04 AF05 AF08 AG01

AH07 AK03 AL02

3F060 AA00 AA09 BA10 EB05 GA01

GA11 HA00

5C001 AA01 AA03 AA04 BB07 CC04

CC07

9A001 BB05 BB06 KK54 LL05 LL08

THIS PAGE BLANK (USPTO)